Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0211U002816

Державний реєстраційний номер: 0106U008489

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-02-2011

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: 91Об'ємні кристали та тонкі плівки складних халькогенідних напівпровідників і оксидів металів: технологія одержання, фізичні властивості та пристрої сонячної енергетики, спінтроніки, сенсорики та дозиметрії

Початок етапу: 01.2006

Закінчення етапу: 12.2010

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 52-61-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201160

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 65.49

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Об'ємні кристали та тонкі плівки складних халькогенідних напівпровідників і оксидів металів: технологія одержання, фізичні властивості та пристрої сонячної енергетики, спінтроніки, сенсорики та дозиметрії

Назва роботи англійською:

Bulk crystals and thin films of the complex chalcogenide semiconductors and metal oxides: technology, physical properties and devices for the solar engineering, spintronics, sensorics and dosimetry based on them

Реферат українською:

В роботі на основі проведення комплексних (електричних, фотоелектричних, оптичних і магнітних) досліджень були встановлені основні закономірності впливу технологічних умов одержання об'ємних кристалів і тонких плівок складних халькогенідних напівпровідників і оксидів металів на їх структурну досконаліть, стехіометричність і фізичні властивості; розроблено лабораторні зразки ряду електронних пристроїв сонячної енергетики, сенсорики, дозиметрії та спінтроніки і досліджено залежність їх експлуатаційних параметрів від типу напівпровідникового матеріалу, конструктивних і технологічних умов створення структур.

Реферат англійською:

Basic objective laws of influence of technological conditions of obtaining volume crystals and thin films of compound halcogenide semiconductors and oxide metals on their structural perfectness, stechiometrity and physical properties were determined on the basis of complex (electric, photoelectric, optic and magnetic) investigations; also there were elaborated laboratory samples of certain electronic devices of solar energetic, sensoryty, dozymetry and spintronics and there was investigated the dependence of semiconductor material, constructive and technological conditions of structures formation.

Індекс УДК: 537.62;621.372.8;666.655, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 29.33.

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мар"янчук Павло Дмитрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1.Vorobiev Yu.V., Gonzalez-Hernandez J., Gorley P., Horley P. And Bulat L. A new approach to hybrid systems of renewable energy utilization // in book: Leading Edge Research in Solar Energy. 2007, Nova Science Publishers, Inc., New York. Editor: Patrick N. Rivers, p.p.147-164. 2.Ковалюк З.Д., Политанская О.А., Сидор О.Н., Маслюк В.Т. Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12,5МэВ // Физика и техника полупроводников.- 2008, том 42,

вып 11. - с.1321-1326. 3.Боледзюк В.Б., Ковалюк З., Пырля М.Н. Оптические и фотоелектрические свойства InSe4, GaSe, интеркалированыних барием. // Неорганические материалы, 2009, т. 45. - №11. - С. 1303-1307.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Ушенко Олександр Григорович
д. ф.-м. н., 01.04.05

Перелік осіб-виконавців

Ілащук Марія Іванівна

Андрущак Галина Олегівна

Білічук Сергій Васильович

Гавалешко Наталя Миколаївна

Горлей Валентина Вікторівна

Грушка Зінаїда Михайлівна

Грушка Олена Григорівна

Козярський Іван Петрович

Козярський Дмитро Петрович

Майструк Едуард Васильович

Мар"янчук Павло Дмитрович

Микитюк Василь Іванович

Мислюк Оксана Михайлівна

Орлецький Іван Григорович

Парфенюк Орест Архипович

Радевич Ярема Іванович

Сльотов Олексій Михайлович

Фрасуняк Василь Михайлович

Хомяк Володимир Васильович

Чупира Сергій Миколайович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

